

エレクトロニクス部会ニュース No. 8

・平成 21 年 11 月 11 日(水)

部会ニュース No. 8 をお届けします。内容は次回幹事会、部会総会、マイクロプロセッシング研究討論会のご案内、11 月 4 日(水)開催幹事会の議事概要、および 8 月 31 日(月)開催のシンポジウムの報告です。

11 月 4 日幹事会の主な議事内容は、化工誌の部会紹介記事、研究賞候補者、低誘電率膜、来年度シンポジウム等についてです。

(1) 平成 21 年度第 5 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。どなたでも出席できますので、どうぞご出席ください。

1. 日時：平成 21 年 12 月 2 日(水) 14:00~16:00
2. 場所：住友ベークライト(株)会議室
3. 議題：部会総会
マイクロプロセッシング研究討論会
来年度シンポジウム 等

(2) 部会総会(資料 1)

上記の幹事会終了後、同じ場所で「部会総会」を開催します。準備の都合上、参加される会員の皆様には資料 1 に示す様式に従ってお申し込み下さい。

(3) 第 1 回マイクロプロセッシング研究討論会(資料 2)

標記の研究討論会を資料 2 に示すように平成 22 年 1 月 21 日(木)13:00 より東工大蔵前会館に於いて開催します。資料 2 の様式に従い参加申込をお願い致します。

(4) 平成 21 年度第 4 回幹事会

標記会議を 11 月 4 日(水)、住友ベークライト(株)にて開催しました。主な議事内容は次の通りです。

1. 電子 S I 連絡協議会報告

(社)電子情報技術産業協会は本協議会の継続に消極的ですが、本部会、(社)日本溶接協会、(社)溶接学会、(社)日本機械学会、ASET 超先端電子技術開発機構などはどちらかといえば継続したいという意向を持っています。今後、本協議会が何をするかということが定まれば、自ずと結論が出ると思われれます。当分は、(独)産業技術総合研究所に事務局を置くとのことです。

2. 化工誌の部会紹介記事

近藤幹事より、原稿案が提出されました。近い将来、化工誌に掲載されることとなります。

3. 研究賞候補者

近藤幹事を推薦することになりました。

4. 低誘電率膜

瀧 健太郎幹事より、「UV 硬化樹脂の光誘起相分離を利用したフレキシブル低誘電率膜の作成」の研究内容について説明がありました。興味をお持ちの会員は事務局に申し出て下さい。近い将来、興味をお持ちの会員を中心に、**本研究内容に関連した研究発表会**を行うことを計画しています。

5. 平成 22 年度シンポジウムについて

石井副部長より来年度シンポジウムの案として、「メディカル・エレクトロニクスとその材料・プロセス」について報告がありました。

(5) シンポジウム「3次元チップ積層-TSV めっき装置と高速化」(資料3)

8月31日(月)、東京大学山上会館に於いて標記シンポジウムが開催されました。TSV(Through Silicon Via)めっきの最新の開発動向について、各専門家に講演して頂きました。講演題目と講演者は資料3の通りです。

資料1

化学工学会エレクトロニクス部会総会開催のご案内

現在のエレクトロニクス部会は本年12月末をもって終了いたします。ただし、来年2010年1月から新しいエレクトロニクス部会として継続することが、化学工学会理事会より認められました。継続期間は2017年12月までの8年間です。

つきましては、下記の要領で本部会の総会を開催し、今までの活動のご報告と、これからの活動方針について、部会員の皆様に御相談致したいと存じます。

ご多忙の折から恐縮に存じますが、何卒ご出席を賜りたく、茲にご案内申し上げます。

記

日時 平成 21 年 12 月 2 日(水) 16:00-19:30

場所 住友ベークライト株式会社 本社 20 階会議室

次第

司会：近藤和夫(代表幹事)

挨拶 (16:00-16:10)

活動報告 (16:10-16:25)

新部会の活動計画 (16:25-16:40)

経理報告・経理計画 (16:40-16:50)

講演『プリント配線板のエッチング技術』(16:50-17:20)

懇親会 (17:30-19:30) (無料)

場所：住友ベークライト会議室

参加申込 準備の都合上、参加される会員の皆様には次の様式に従ってご記入の上、山本：

electro@chemeng.osakafu-u.ac.jp宛てお申し込み下さい。

「部会総会」参加申込書

氏名：東京 太郎 (トウキョウ タロウ)

所属：三井ベークライト株式会社 生産技術部 電子部品課

メールアドレス：tokyo@sanbe.ac.jp

電話：03-123-4567

懇親会参加：有または無

資料 2

第 1 回マイクロプロセッシング研究討論会のご案内

本研究討論会は、『高密度 3 次元 LSI 製造技術および実装技術の高度化』を大きな目標とし、それを達成するためのいくつかの技術のうち、**微細加工技術に関連する化学工学的な研究**に的を絞った研究討論会です。

討論会の形式は、**ディスカッション主体**(別名：ワイガヤ形式)とし、参加者としては「エレクトロニクス部会の法人会員に所属する技術者・研究者+エレクトロニクスに関連する諸問題に興味を持つ化学工学関連の研究者」を考えています。討論会ですので、単なる講演者からフロアへの一方通行ではなく、フロアの人たちも講演者と一緒になって、当面する技術課題について議論する場としたいと考えています。

つきましては、第 1 回の「マイクロプロセッシング研究討論会」を下記の要領で開催いたしますので、ご出席のほどお願い申し上げます。

記

日時 平成 22 年 1 月 21 日(木)

場所 東工大蔵前会館

〒152-0033 東京都目黒区大岡山 2 丁目 12 番 1 号 (大岡山駅正面：東工大正門を左に見て正面) phone 03-5734-3737

講演(一部変更の可能性あり)

13:00-13:45	有機物複合汚染の挙動と解析	羽深 等(横浜国大)
13:45-14:30	インクジェット法による薄膜形成	深井 潤(九州大)
14:30-15:15	銀配線間のイオンマイグレーションによる短絡	荻野文丸(京都大)
15:15-15:30	休憩	
15:30-16:15	三次元実装電極めっきの高スループット化	近藤和夫(大阪府大)
16:15-17:00	フレキシブル放熱基板の開発	井口 裕(三井金属)
17:15-19:30	交流会(全員ご参加下さい。)	

参加費：5,000 円(当日お支払い下さい。)

連絡先：荻野 文丸 メールアドレス fyogino@cameo.plala.or.jp

参加申し込み：次の様式に従ってご記入のうえ、上記連絡先メールアドレスに送信して下さい。

「第 1 回マイクロプロセッシング研究討論会」参加申込書

氏名：東京 太郎 (トウキョウ タロウ)

所属：三井ベークライト株式会社 生産技術部 電子部品課

メールアドレス：tokyo@sanbe.ac.jp

電話：03-123-4567

会員資格：エレクトロニクス部会個人会員

(エレクトロニクス部会個人会員、エレクトロニクス部会個人特別会員、化学工学会会員、大学関係者、そ

の他、からお選び下さい。)

資料 3

シンポジウム「3次元チップ積層-TSVめっき装置と高速化」

- ・「(基調講演)微細化の課題と三次元積層時代の到来」
大場 隆之(東京大学工学系研究科)
- ・「低抵抗貫通ビア形成に向けたパーフェクトコンフォーマル無電解銅メッキ技術」
新宮原 正三(関西大学システム理工学部)
- ・「ポイドフリー、再現性の高いシリコン貫通ビアめっきを可能にした銅メッキプロセス」
秋山 浩一(エンソソジャパン株式会社)
粕谷 豊(日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社)
- ・「貫通電極形成における高速Viaめっき技術」
門田 裕行(日立協和エンジニアリング株式会社)
- ・「高速TSVめっきとそのメカニズム」
近藤 和夫(大阪府立大学工学研究科)
- ・「シリコン貫通電極形成のためのCu電解めっき装置技術」
福永 明((株)荏原製作所)
- ・「Copper Plating Advances for TSV Processing」
Setiagung Casimirus(Semitool)

以上